

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成18年1月5日(2006.1.5)

【公表番号】特表2001-520446(P2001-520446A)

【公表日】平成13年10月30日(2001.10.30)

【出願番号】特願2000-516391(P2000-516391)

【国際特許分類】

<i>H 01 M</i>	<i>4/88</i>	<i>(2006.01)</i>
<i>C 25 B</i>	<i>11/04</i>	<i>(2006.01)</i>
<i>G 01 N</i>	<i>27/28</i>	<i>(2006.01)</i>
<i>H 01 M</i>	<i>4/86</i>	<i>(2006.01)</i>
<i>H 01 M</i>	<i>8/10</i>	<i>(2006.01)</i>
<i>C 25 B</i>	<i>9/00</i>	<i>(2006.01)</i>

【F I】

<i>H 01 M</i>	<i>4/88</i>	<i>C</i>
<i>C 25 B</i>	<i>11/04</i>	<i>A</i>
<i>G 01 N</i>	<i>27/28</i>	<i>Z</i>
<i>G 01 N</i>	<i>27/28</i>	<i>3 3 1 D</i>
<i>H 01 M</i>	<i>4/86</i>	<i>H</i>
<i>H 01 M</i>	<i>8/10</i>	
<i>C 25 B</i>	<i>9/00</i>	<i>E</i>

【手続補正書】

【提出日】平成17年6月27日(2005.6.27)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 a) 多孔質膜にイオン伝導性電解質を部分的に充填して部分充填膜を作製する工程と；

b) 前記部分充填膜から空隙体積をなくし、電極粒子を前記部分充填膜に埋め込むように前記部分充填膜と前記電極粒子を互いに圧縮する工程とを含む膜電極アセンブリの作製方法。

【請求項2】 前記電極粒子がナノ構造要素である請求項1に記載の方法。

【請求項3】 前記多孔質膜を部分的に充填する前記工程が、a) 多孔質膜をイオン伝導性電解質の溶液に浸漬し、次にb) 前記膜を乾燥することを含む少なくとも1つの浸漬工程を含む請求項1又は2に記載の方法。

【請求項4】 前記多孔質膜を部分的に充填する前記工程が、多孔質膜とイオン伝導性電解質の溶液とを互いに機械的に圧縮することを含む請求項1又は2に記載の方法。

【請求項5】 前記多孔質膜を部分的に充填する前記工程が、空気圧差によってイオン伝導性電解質の溶液を多孔質膜に強制的に送り込むことを含む請求項1又は2に記載の方法。